

二甲基亚砷中半导体上脉冲电沉积Bi薄膜

作者: 袁定胜 潘文杰 刘冠昆等 发表时间: 2003-5-1 9:08:50

从原有的化学镀铜的工业配方出发, 对其用量进行改良, 特别是镀液的pH值调试, 配体的使用和还原剂的用量, 在硅片上沉积出一层光亮而且致密的铜薄膜. 结果表明, 在二甲基亚砷中硅铜基体上的电沉积铋薄膜均匀、致密、粘附力强, XRD测试表明铋以晶体析出.



[加入收藏]



[打印本页]



[网上投稿]



[关闭返回]

版权所有: 材料保护杂志社 中国表面工程信息网络中心 鄂ICP备05001264

Tel: 027-83330037 Fax: 027-83638752 E-mail: abc430030@126.com

短信平台: 编辑“材料保护”发送到106650120留言 (0.1元/条, 接收免费)